

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成24年3月29日 (2012.3.29)

【公表番号】特表2006-524427(P2006-524427A)

【公表日】平成18年10月26日 (2006.10.26)

【年通号数】公開・登録公報2006-042

【出願番号】特願2006-504301(P2006-504301)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/20 (2006.01)

H 0 1 L 21/02 (2006.01)

H 0 1 L 27/12 (2006.01)

H 0 1 L 21/265 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/20

H 0 1 L 27/12 B

H 0 1 L 21/265 Q

H 0 1 L 21/265 6 0 2 A

H 0 1 L 21/265 V

【誤訳訂正書】

【提出日】平成24年2月9日 (2012.2.9)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 2 7

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0 0 2 7】

このようなエピタキシャル層構造又はウェーハは、有利には一回の成長プロセスで製造することができる。この場合、特に有利には、ウェーハを反応器内に留めておいて、負担のかかる研磨及び洗浄無しに成長させることができる。